

1. Херман, Полупроводниковые сверхрешетки, 1989 г., Мир, М., с. 238.
2. Зеленин, О. С. Горя, Ю. В. Жилиев, Выращивание многослойных периодических структур из газовой фазы на основе GaAs/GaAs<sub>1-x</sub>P<sub>x</sub> гетеропереходов, 1990 г., Молд. НИИНТИ, Кишинев, с. 11.
3. Crystal Properties and Preparation, v. 32-34, 1991, O. S. Gorea, V. V. Zelenin, A. V. Koval, A. V. Simashkevich, GaAs/ GaAsP superlattices grown by the chloride VPE using single flat temperature zone, p. 503-507.
4. Revue Technique Tomson - CCSF, v. 13, nr. 2, 1981, I.F. Hittz et G. Reuchet, Deux methodes originales de croissance epitaxiale en phase vapeur de composes GaInAs et GaInAsP.